








	<h2>BSM180D12P2C101</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSM180D12P2C101</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> LAPIS Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 1200V 180A MODULE</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.BSM180D12P2C101.pdf</a> <a href="#">2.BSM180D12P2C101.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1500 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	BSM180D12P2C101
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 1200V 180A MODULE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1500 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Leistung - max	1130W
Verpackung / Gehäuse	Module
Supplier Device-Gehäuse	Module
Typ FET	2 N-Channel (Half Bridge)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1200V (1.2kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	180A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	-
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 35.2mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	23000pF @ 10V
Verpackung	Bulk

BSM180D12P2C101 ist neu im Original, Suche BSM180D12P2C101 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BSM180D12P2C101 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BSM180D12P2C101: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>BSM180D12P3C007</b> LAPIS Semiconductor SIC POWER MODULE</p>	 <p><b>BSM16A-35XG</b> BCT IGBT Modules</p>	 <p><b>BSM16A-3SX</b> Original</p>	 <p><b>BSM191AR</b> SIEMENS IGBT Modules</p>
 <p><b>BSM181AR</b> SIEMENS IGBT Modules</p>	 <p><b>BSM181FR</b> SIEMENS IGBT Modules</p>	 <p><b>BSM15GP60</b> IGBT Module BSM15GP60 IGBT Module</p>	 <p><b>BSM15GP60BOSA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) IGBT 2 LOW POWER ECONO2-5</p>

### heiße Teile

Mehr

⚙ BSM15GD120DN1	➔ BSM15GD120DN12	➔ BSM15GD120DN12.2E	D BSM15GD120DN2	➔ BSM15GD120DN2-1310
⊣ BSM15GD120DN2-E3224	⚙ BSM15GD120DN2E	D BSM15GD120DN2E3224	➔ BSM15GD120DN2E3226	➔ BSM15GD120DN2E3256
⚙ BSM15GD120M	⊣ BSM15GD60DL	⚙ BSM15GD60DLC	➔ BSM15GD60DN1	➔ BSM15GD60DN1E3156
D BSM15GD60DN2	⚙ BSM15GP060	⊣ BSM15GP120	⚙ BSM15GP120 B2	➔ BSM15GP120-B2
➔ BSM15GP120B2	➔ BSM15GP120DN2	⚙ BSM15GP120_B2	⊣ BSM15GP60	➔ BSM16A-35XG
➔ BSM181AR	➔ BSM181FR	D BSM191AR	⚙ BSM195GAL124DN	⊣ BSM200GA100D
⚙ BSM200GA100DN1	D BSM200GA100DN11	➔ BSM200GA120D	➔ BSM200GA120DLC	➔ BSM200GA120DLCS
⊣ BSM200GA120DN1	⚙ BSM200GA120DN11	➔ BSM200GA120DN11S	➔ BSM200GA120DN2	➔ BSM200GA120DN2C
⚙ BSM200GA120DN2E3256	⊣ BSM200GA120DN2FS	⚙ BSM200GA120DN2S	D BSM200GA120DN2S3256	➔ BSM200GA120DN2SE
➔ BSM200GA120DNS	⚙ BSM200GA12DLC	⊣ BSM200GA160D	⚙ BSM200GA160DN11S	➔ BSM200GA170DLC

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited